

1SV223

(開発中/Under Development)

シリコンエピタキシャルプレーナ形バリキャップダイオード

Silicon Epitaxial Planar Variable Capacitance Diode

● 特長

- 1) 超小型である。(ダブルリードスーパーミニモールドタイプ)
- 2) 高信頼度である。

● Features

- 1) Ultrasmall size (doublelead super-mini mold type)
- 2) High reliability

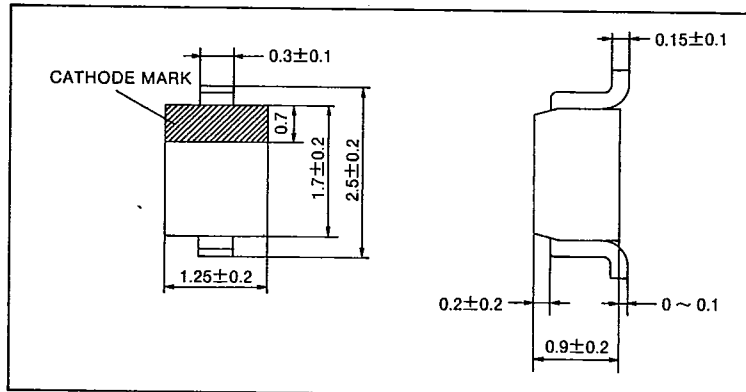
● 用途

同調用

● Applications

For tuning

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



ダイオード



バリキャップダイオード

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
尖頭逆電圧	V_{RM}^*	35	V
直流逆電圧	V_R	30	V
接合部温度	T_j	120	$^\circ\text{C}$
保存温度範囲	T_{stg}	$-30 \sim +120$	$^\circ\text{C}$

* $R_L > 10\text{k}\Omega$ ● 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
逆方向電流	I_R	—	—	10	nA	$V_R = 28\text{V}$
端子間容量	C_{t1}	14.0	—	16.04	pF	$V_R = 2\text{V}, f = 1\text{MHz}$
	C_{t2}	2.05	—	2.39	pF	$V_R = 25\text{V}, f = 1\text{MHz}$
直列抵抗	R_S	—	—	0.6	Ω	$C_t = 14\text{pF}, f = 470\text{MHz}$